

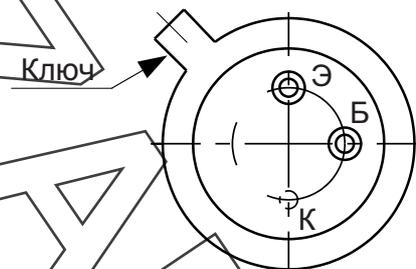
ДП КВАЗАР-ИС

ЭТИКЕТКА

Транзисторы: 2Т3108А,
2Т3108Б, 2Т3108В.

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы 2Т3108А, 2Т3108Б, 2Т3108В выполненные в металло-стеклянном корпусе типа КТ-1-7 (ТО-18) и предназначены для применения в радиоэлектронных устройствах широкого назначения.

Схемы расположения выводов



Масса не более 0,5 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквен- ное обозна- чение	Норма					
		2Т3108А		2Т3108Б		2Т3108В	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кб} = 1 \text{ В}$, $I_{э} = 10 \text{ мА}$)	$h_{21Э}$	50	150	50	150	100	300
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кб} = 60 \text{ В}$ для 2Т3108А, $U_{кб} = 45 \text{ В}$ для 2Т3108Б, 2Т3108В)	$I_{кб0}$	-	0,2	-	0,2	-	0,2
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{эб} = 5 \text{ В}$)	$I_{эб0}$	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Напряжение насыщения коллектор-эмиттера, В ($I_{к} = 10 \text{ мА}$, $I_{б} = 1 \text{ мА}$)	$U_{кэнас}$	-	0,25	-	0,25	-	0,25
Коэффициент шума, дБ ($U_{кэ} = 5 \text{ В}$, $I_{к} = 1 \text{ мА}$, $f = 100 \text{ МГц}$, $R_{г} = 50 \text{ Ом}$)	$K_{ш}$	-	6	-	6	-	6
Ёмкость коллекторного перехода, пФ ($U_{кб} = 10 \text{ В}$, $f = 5 - 10 \text{ МГц}$)	$C_{к}$	-	5	-	5	-	5
Ёмкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{эб} = 1 \text{ В}$, $f = 5 - 10 \text{ МГц}$)	$C_{э}$	-	6	-	6	-	6
Время рассасывания, нс ($I_{к} = 10 \text{ мА}$, $I_{б1} = I_{б2} = 1 \text{ мА}$)	$t_{рас}$	-	175	-	175	-	-
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс ($U_{кб} = 10 \text{ В}$, $I_{к} = 10 \text{ мА}$, $f = 30 \text{ МГц}$)	$t_{к}$	-	250	-	250	-	250

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т3108А, 2Т3108Б, 2Т3108В соответствуют техническим условиям
аА0.339.026 ТУ.